Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

УДК 548

№ ГР 20051153

Инв №

УТВЕРЖДАЮ Проректор УО «ВГТУ» по научной работе С.М.Литовский 2005 г.

ОТЧЕТ

О научно-исследовательской работе «Компьютерное моделирование оптических центров ионов Tm³⁺ в кварцевом гель-стекле системы SiO₂-TiO₂-Tm₂O₃» 2005 $\Gamma/\bar{B} - 333$

(Заключительный)

Научный руководитель

Начальник НИС

А.А.Корниенко С.А.Беликов

Витебск, 2005г



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель

доктор физ.-мат наук, профессор, г.н.с

23.12.05 Жори

Корниенко Алексей Александрович

Bocquine, journouve

Исполнители:

кандидат физ.-мат наук, доцент, с.н.с.

дата, подпись

Дунина Елена Брониславовна

paysen 2-3

аспирант, м.н.с.

дата, подпись

Фомичёва Людмила Александровна

porgen 1

Инженер

дата, подпись

Сапежинский Валерий Степанович

paysar 4

Нормоконтролёр

дата, подпись

Сапежинский Валерий Степанович

РЕФЕРАТ

Отчет 24с., 10 табл., 26 источников.

ТУЛИЙ, КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, ИНТЕНСИВНОСТИ МЕЖМУЛЬТИПЛЕТНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ОПТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ.

Объектом исследования являются лазерные кристаллы и стекла, активированные ионами Tm^{3+}

Цель работы — разработать методы, алгоритмы и комплект программ для описания и предсказания спектроскопических свойств лазерных материалов, активированных ионами Tm^{3+}

В процессе работы проводились только теоретические исследования и компьютерное моделирование основных оптических свойств.

В результате исследования впервые были предсказаны характеристики интенсивности поглощения люминесценции иона ${\rm Tm}^{3+}$ в кристалле ${\rm LiYF_4}$ на основе анализа тонких деталей штарковской структуры мультиплетов.

Выполнено компьютерное моделирование оптических центров с ионами ${\rm Tm}^{3+}$ в стекле и сделан вывод, что увеличить выход люминесценции на важном с точки зрения практического применения переходе ${}^3H_4 \to {}^3F_4$ можно, синтезируя стекла с оптическими центрами кубической симметрии.

Степень внедрения рекомендации по синтезу стекол с оптическими центрами перспективной симметрии переданы в Институт молекулярной и атомной физики для экспериментальной проверки.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
	Основная часть	7
1.	Вычисление волновых функций и энергии мультиплетов Eu и Tm в	
	приближении свободного иона	7
2.	Расчет матричных элементов единичных неприводимых тензоров	8
3.	Расчет параметров кристаллического поля в модели точечных зарядов	
	и в модели обменных зарядов	11
3.1	Гамильтониан кристаллического поля	11
3.2	Приближение промежуточного конфигурационного взаимодействия	
	для электрических дипольных переходов	12
3.3	Определение нечетных параметров кристаллического поля и	
	параметров ковалентности	13
3.4	Сравнение с экспериментом и обсуждение результатов	
	моделирования	14
4.	Расчет относительной интенсивности отдельных люминесцентных	
	полос	17
4.1	Основные формулы теории интенсивностей	17
	D	
4.2		
	Tm ³⁺	20
	Заключение.	12
	Список использованных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Современный уровень развития лазерной техники, оптоэлектроники, информатики и сенсорики требует создания новых материалов с заданным Перспективными свойств. комплексом для данных целей являются обладающие высокими эксплуатационными параметрами материалы на основе силикатов и боратов, активированные ионами переходных и редкоземельных элементов. В настоящее время такие материалы используются в качестве сред лазеров И усилителей, оптических волноводов, активных люминесцентных преобразователей оптического излучения и ионизирующей радиации, биологических материалов и т. д. Существенного прогресса в синтезе новых перспективных материалов можно достичь только с помощью методов компьютерного моделирования спектроскопических свойств. при этом надо иметь в виду, что методы расчета спектроскопических свойств кристаллов более устоявшиеся, чем методы расчета свойств неупорядоченных сред.

В связи с этим методы описания и прогнозирования спектроскопических свойств сначала проверяются на кристаллах. Компьютерное моделирование базируется на предположении [1] о существовании корреляции между интенсивностями электрических дипольных переходов и тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов. Основой такого предположения является тот факт, что для редкоземельных ионов, занимающих в кристалле нецентрально-симметричные положения, примесь одних и тех же нижайших по энергиям возбужденных конфигураций частично снимает запрет на внутриконфигурационные f-f переходы и дает заметный вклад в энергию штарковских уровней.

В работе [2] существование этой корреляции было подтверждено для иона ${\rm Tm}^{3+}$ в ${\rm Y}_3{\rm Al}_5{\rm O}_{12}$, где при описании штарковской структуры мультиплетов с помощью гамильтониана кристаллического поля в приближении промежуточного по силе межконфигурационного взаимодействия [3] были определены не только параметры кристаллического поля четной симметрии, но и параметры ковалентности и нечетные параметры кристаллического поля. Затем с помощью определенных таким образом параметров ковалентности и нечетных параметров кристаллического поля были вычислены параметры интенсивности, которые находились в удовлетворительном согласии с экспериментальными значениями.

В случае подтверждения существования корреляции между тонкими штарковской структуры мультиплетов И интенсивностями электрических дипольных f-f переходов для других ионов, ее можно было бы предсказания важных спектроскопических использовать ДЛЯ кристаллах редкоземельных ионов В лазерных стеклах И

взаимосогласованного описания штарковской структуры и характеристик интенсивности поглощения и люминесценции. Такое взаимосогласованное описание актуально для верификации экспериментальных результатов.

С целью проверки выше упомянутой корреляции выполнено описание штарковской структуры иона Tm^{3+} в LiYF₄, а затем на основе полученных результатов выполнен расчет параметров интенсивности. Основанием для выбора кристалла LiYF₄: Tm^{3+} послужили следующие обстоятельства. 1) известны экспериментальные значения энергии штарковских уровней, 2) при кристаллическом расщеплении мультиплеты не перекрываются, следовательно, нет проблем с идентификацией уровней 3) в работах [4,5] было показано, что удовлетворительного описания штарковской структуры можно достичь только при учете влияния возбужденных конфигураций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Корниенко А.А., Каминский А.А., Дунина Е.Б. Влияние межконфигурационного взаимодействия на кристаллическое поле ${\rm Ln}^{3+}$ ионов // ЖЭТФ 1999. Т.116, Вып. 6, С. 2087
- 2. Корниенко А.А., Дунина Е.Б. Определение параметров интенсивности по тонким деталям штарковской структуры энергетического спектра иона Tm^{3+} в $Y_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ //Опт. и спектр. 2004. Т.97, №1, С. 75-82.
- 3. Корниенко А.А., Дунина Е.Б. Зависимость штарковской структуры от энергии мультиплетов // Письма в ЖЭТФ. 1994. Т.59, №6, С. 385
- 4. Garcia D., Faucher M. An explanation of the ¹D₂ anomalous crystal field splitting in PrCl₃ // J Chem. Phys. 1989. V.90, №10, P 5280 5283.
- 5. Garcia D., Faucher M. A full calculation of multiconfiguration interaction effects up to 120 000 cm⁻¹ (15 eV) on the ground configuration state levels of PrCl₃. Zeeman effect interpretation // J. Chem. Phys. 1989 V.91, №12, P 7461 7466.
- 6. Kornienko A.A., Kaminskii A.A., Dunina E.B. Dependence of the Line Strength of f-f transitions on the Manifold Energy I. Projector on the Basis of Nonorthogonal Functions // Phys. Stat. Sol. (b). 1990 V 157, №1, P 267.
- 7 Дунина Е.Б., Каминский А.А., Корниенко А.А., Курбанов К., Пухов К.К. Зависимость силы линий электрических дипольных f-f переходов от энергии мультиплетов иона Pr^{3+} в YAlO₃ // ФТТ 1990 Т.32, С. 1568
- 8. Kamınskıı A.A., Kornienko A.A., Chertanov M.I. Parameterization of Electric-Dipole Intensities in f^N Systems Due to Electron-Correlation Effects //Phys. Stat. Sol. (b). 1986. V 134, №2, P 717
- 9 Wyckoff R.W.G Crystal structures // Interscience publishers LTD., London. 1951
- 10.Kay M.J., Frazer B.C., Almodovar I. Neutron Diffraction Refinement of CaWO₄ // J Chem. Phys. 1964. V.40, P. 504.
- 11. Jenssen H.P., Linz A., Leavitt R.P., Morrison C.A., Wortman D.E. Analysis of the optical spectrum of Tm³⁺ in LiYF₄ // Phys. Rev B. 1975 V 11, №1, P 92 101
- 12. Anikeenok O.A., Eremin M.V., Falin M.L., Konkın A.L., Meiklyar V.P ENDOR and transferred spin densities of the 4f¹¹ ions in fluorides // J Phys. C Solid state Phys. 1984. V 17, P 2813 2823
- 13 Каминский А.А., Антипенко Б.М. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров // М., Наука. 1989 270 С.
- 14.Peacock R.D. The Intensities of Lanthanide f-f Transitions // Struct. and Bond. 1975 V.22, P 83
- 15. Басиев Т Т., Карасик А.Я., Корниенко А.А., Папашвили А.Г., Пухов К.К. Сверхчувствительный электронный переход в примесных Nd-Nd нано-кластерах кристалла CaF₂ // Письма в ЖЭТФ 2003 Т 78, №5, С. 768 771

- 16.Carnall W T., Fields P.R., Rajnak K. Electronic Energy Levels in the Trivalent Lanthanide Aquo Ions. I. Pr³⁺, Nd³⁺, Pm³⁺, Sm³⁺, Dy³⁺, Ho³⁺, Er³⁺ and Tm³⁺ // J.Chem.Phys. 1968. V.49, №10, P 4424.
- 17. Корниенко А.А., Дунина Е.Б., Шадурский А.В. Алгоритм вычисления интегралов перекрывания в системе компьютерной алгебры «МАРLЕ» // Вестник УО «Витебский государственный технологический университет» 2005 Вып.7, С. 137-140
- 18. Dunina E.B., Fomicheva L.A., Kornienko A.A. Correlation between the Stark multiplet structure and absorption line intensities of Tm³⁺ in LiYF₄ // Physics of electronic materials. 2nd International Conference Proceedings. Kaluga, Russia, May 24-27, 2005 P 301-304.
- 19 Орехова А., Дунина Е.Б. Применение метода наименьших квадратов для определения параметров интенсивности // Тезисы докладов XXXVIII научно-технической конференции преподавателей и студентов университета / УО «ВГТУ» Витебск: УО «ВГТУ» 2005. С. 101
- 20. Корниенко А.А., Фомичева Л.А., Дунина Е.Б. Описание штарковской структуры иона Tm^{3+} в LiYF₄ с учетом межконфигурационного взаимодействия // Актуальные проблемы физики твердого тела. сб. докл. Междунар. науч. конф., 26–28 окт 2005г., Минск. В 2 т Т 2 / редкол. Н.М. Олехнович и др. Мн. . Изд. центр БГУ, 2005. С. 163 165
- 21 Фомичева Л.А., Корниенко А.А., Дунина Е.Б. Определение параметров ковалентности на основе анализа штарковской структуры мультиплетов иона Тт в LiYF₄ // Оптика 2005 Труды четвертой международной конференции молодых ученых и специалистов «Оптика-205». Санкт—Петербург, 17-21 октября 2005 Под. ред. проф. В.Г.Беспалова, проф. С.А.Козлова. СПб. СПбГУ ИТМО. 2005 С. 291 292.
- 22. Малашкевич Г.Е., Шевченко Г.П., Бокшиц Ю.В., Корниенко А.А., Першукевич П.П. Оптические центры Eu^{3+} с высокой эффективностью перехода 5D_0 -> 7F_4 в алюминатных гель-пленках // Оптика и спектр. 2005 Т98, С. 224.
- 23. Дунина Е.Б., Фомичева Л.А., Корниенко А.А. Расчет интенсивности абсорбционных переходов лазерного кристалла LiNbO₃. Dy³⁺ в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия // Вестник УО «Витебский государственный технологический университет» Ориентировочно вып. 10
- 24.Гайдук М.И., Золин В.Ф., Гейгерова Л.С. Спектры люминесценции европия // М., Наука. 1974. 195 С.
- 25 Carnall W T., Fields P.R., Wybourne B G. Spectral Intensities of the Trivalent Lanthanides and Actinides in Solution. I. Pr³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, Tm³⁺, and Yb³⁺ // J Chem. Phys. 1963 V.42, P 3797 3806.
- 26.Lakshman S.V.J., Kumar A.S. Spectral studies of Pr³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, and Tm³⁺ ions in a sodium borophosphate glass // Phys. Chem. Glasses. 1989 V.30, P 35 38



БІБЛІЯТЭКА
уа "ВІЦЕБСКІ ДЗЛРЖАЎНІІ
ТЭХНАЛАГІЧНЫ УІЛВЕРСІІЗІ
ІНВ №